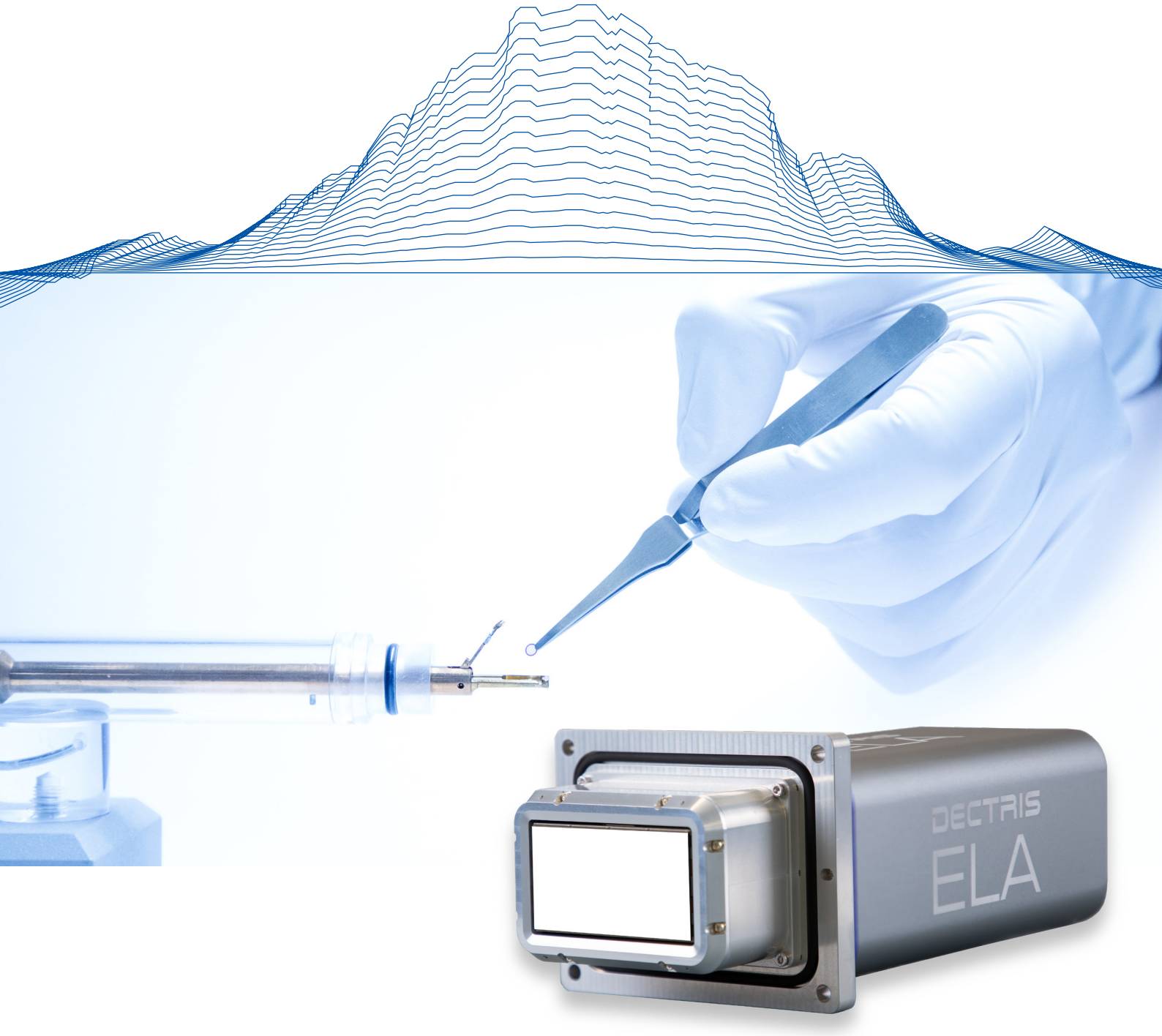
德科特思

DECTRIS
detecting the future



DECTRIS ELA

新型混合像素电子探测器

微信公众号



技 术 规 格

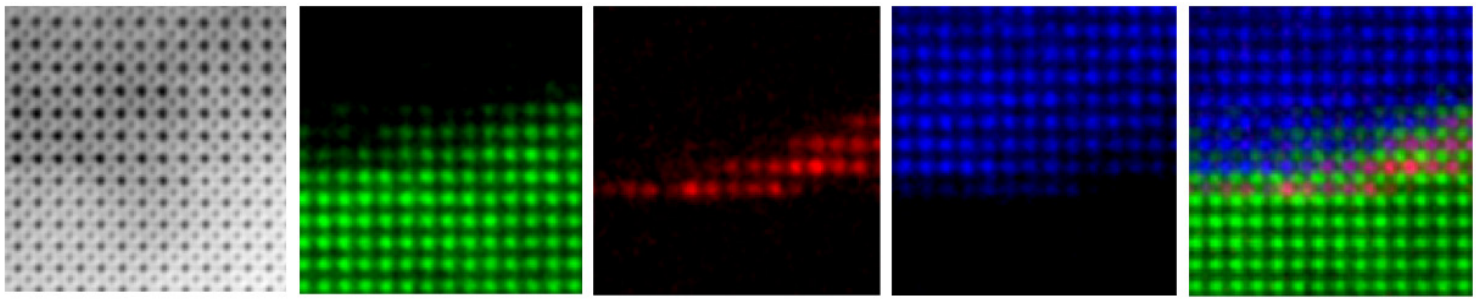
帧速率	2,250 Hz at 16 bits 4,500 Hz at 8 bits 18,000 Hz with ROI mode
计数能力	> 1 pA/pixel
像素数	1,024 x 512
传感材料	硅
图像深度	32 bits
能量范围	30-200 keV
点扩散函数	< 1.3 pixel at 200 keV

所有规格如有更改，恕不另行通知

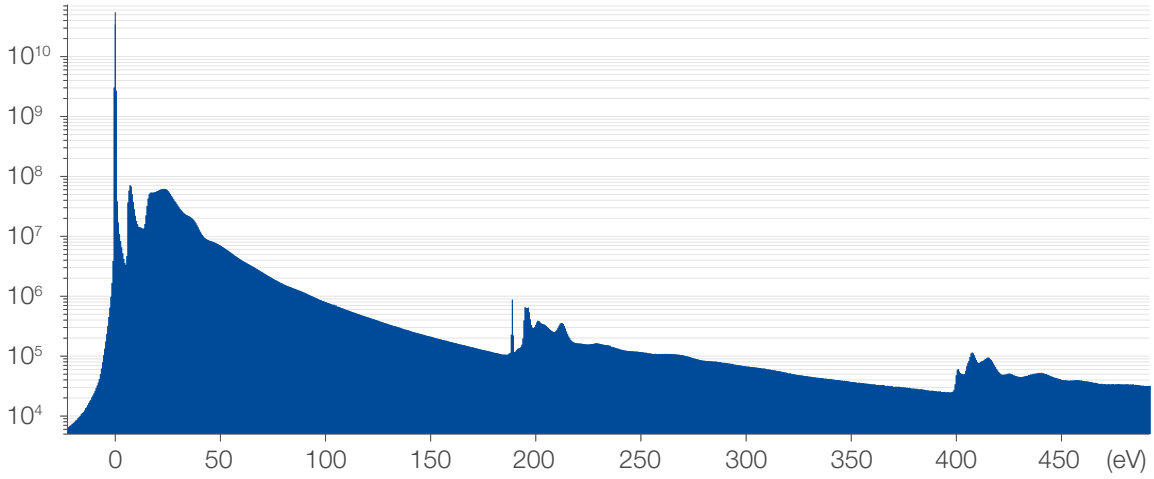
EELS 和 DECTRIS ELA 结合的新纪元

采用DECTRIS混合像素技术的ELA探测器为电子能量损失谱（EELS）提供了前所未有的速度，灵敏度和动态范围，是用于EELS的理想电子计数探测器。它可以处理远远超过100pA的探针电流，同时记录高强度的零损峰和高损峰，并在全能量谱范围内进行单电子计数。其高帧频速率允许一次性快速获取元素面分布结果，特别适合电子束敏感材料的分析。得益于其无死区读出能力，您不仅不会在两帧图像之间丢失电子，确保能够收集样品所能提供的所有信息。与高分辨率光谱仪相结合，DECTRIS ELA 探测器将显著改进 EELS 和 4D-STEM 等应用发展，使您的实验在几分钟内完成，同时提高仪器的利用率，并大大减少操作时间。

Plotkin-Swing, Benjamin, et al. „Hybrid pixel direct detector for electron energy loss spectroscopy.“ Ultramicroscopy (2020): 113067.



Fast elemental mapping of an STO/BTO/LMSO multilayer, including the unsaturated ZLP, acquired as 32 separate 128 x 128 spectrum images of 8 s each, aligned and summed (4.3 min total). From Left to Right: ZLP intensity map, similar to a bright-field image. Map of Ti L2,3 edge. Map of Ba M4,5 edge. Map of La M4,5 edge. RGB composite map. (Image courtesy: NION Ltd.)



EELS of hexagonal boron nitride with E0 60 keV, beam current of 105 pA, 100 s exposure, and energy dispersion set to 0.5 eV/channel, acquired using a Nion Iris EEL spectrometer on a Nion UltraSTEM 200MC monochromated scanning transmission electron microscope. (Image courtesy: NION Ltd.)

中国EM探测器分销商 – 上海微纳国际贸易有限公司

Tel：021-3103 7266 服务热线：400-606-8199 Email：info@ghitcsh.com 网址：www.ghitcsh.com 地址：上海市顺庆路650号5号楼B栋

DECTRIS Ltd.
Täfernweg 1
5405 Baden-Dättwil
Switzerland

Phone +41 56 500 21 00
Fax +41 56 500 21 01
E-Mail sales@dectris.com
www.dectris.com

Registered trademarks: „DECTRIS“: EU, JP, CN, KR (IR0911969), USA (3,307,634); “detecting the future“: EU, AU, CN, KR, JP, AUS (1191333), USA (4,607,800); “DECTRIS INSTANT RETRIGGER“: CN, KR, JP, EU, AUS (IR1224728), USA (4,797,363); Patent Number EP2734861B1, US9081103B2.
© DECTRIS Ltd., all rights reserved • Printed July 2020 • Rev.0